

MODEL CUANTIC PENTRU UN NANOTEC

IRINEL CASIAN-BOTEZ

Este propus un model pentru nanoTECMOS cu lungimi de poarta sub 100 nm bazat pe modelul cu un singur nivel energetic al canalului. Modelul de transport este studiat impreuna cu ecuatia Poisson a potentialului. Codul sursa creat permite reprezentarea caracteristicilor $I-V$ ale tranzistorului.